【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年6月9日(2016.6.9)

【公開番号】特開2014-7395(P2014-7395A)
【公開日】平成26年1月16日(2014.1.16)
【年通号数】公開・登録公報2014-002
【出願番号】特願2013-113252(P2013-113252)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　33/16　　(2010.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　33/00　　１６０

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月19日(2016.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属酸化物半導体基板上の発光ダイオード層を有し、
前記金属酸化物半導体基板は複数の結晶を有し、
前記結晶は、ｃ軸が前記金属酸化物半導体基板の表面に概略垂直である発光デバイス。
【請求項２】
請求項１において、前記金属酸化物半導体基板と前記発光ダイオード層との間にバッファ層を有する発光デバイス。
【請求項３】
請求項１又は請求項２において、前記金属酸化物半導体基板は、基底基板上に設けられている発光デバイス。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか一項において、前記発光ダイオード層は、第１のクラッド層と、前記第１のクラッド層上の発光層と、前記発光層上の第２のクラッド層を有し、
前記第１のクラッド層、前記発光層、及び前記第２のクラッド層は、それぞれ１３族－１５族化合物半導体である発光デバイス。
【請求項５】
請求項１乃至４のいずれか一項において、前記発光ダイオード層は、第１のクラッド層と、前記第１のクラッド層上の発光層と、前記発光層上の第２のクラッド層を有し、
前記第１のクラッド層は、ｎ型１３族－１５族化合物半導体であり、
前記発光層は、１３族－１５族化合物半導体であり、
前記第２のクラッド層は、ｐ型１３族－１５族化合物半導体である発光デバイス。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか一項において、前記金属酸化物半導体基板はガリウムを含む発光デバイス。
【請求項７】
請求項１乃至５のいずれか一項において、前記金属酸化物半導体基板はインジウム及びガリウムを含む発光デバイス。
【請求項８】
請求項１乃至５のいずれか一項において、前記金属酸化物半導体基板はインジウム、ガ

リウム、及び亜鉛を含む発光デバイス。